

貴社整理番号：210201SG01

弊所整理番号：T1233ANP0009-SG/KAT

【書類名】要約書

【要約】

【解決手段】一つの例示的实施形態において、基板処理装置が提供される。基板処理装置は、チャンバと、チャンバ内に設けられた基板支持器と、チャンバ内に設けられ、HFガス及び $C_xH_yF_z$ ガス（ x 及び z は1以上の整数であり、 y は0以上の整数である。）を含む反応ガスの供給源に接続されるガス供給部と、ガス供給部からチャンバ内に供給される反応ガスからプラズマを生成するように構成されたプラズマ生成部と、を備え、チャンバ内でプラズマに暴露される部分の少なくとも一部が導電性のシリコン含有材料で構成されている。

【選択図】図1